

Prof. Dr. Kvon Ze Don

Adresse*	Russian Academy of Sciences Siberian Branch Rzhanov Institute of Semiconductor Physics 630090 Lavrent'ev str., 13 630090 Novosibirsk
Fachgebiet	Physik
Spezialgebiet	Condense matter physics
persönliche Website	http://www.isp.nsc.ru/

Projekte

Terahertz optoelectronics in novel low-dimensional narrow gap semiconductor nanostructures

Bewilligung: 05.12.2019

Opto-electronic and transport phenomena in narrow gap semiconductor structures for terahertz detection

Bewilligung: 28.02.2016

* letzte der Stiftung bekannte Adresse